

uebung_2.1.1

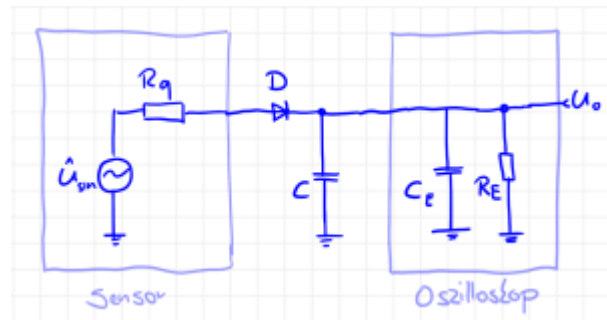
Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Aufgabe 2.1.1 Diode bei höheren Frequenzen 3

Aufgabe 2.1.1 Diode bei höheren Frequenzen



In Ihrer Firma „HHN Mechatronics & Robotics“ haben Sie einen Eintaktgleichrichter aufgebaut, um ein sinusförmiges Messsignal von ($f=200\text{kHz}$, Amplitude $\hat{U} = 5,0\text{V}$, Ausgangswiderstand des Sensors $R_q = 10\text{k}\Omega$) gleichzurichten. Dazu haben Sie eine einfache Schaltung mit der „Si-Gleichrichterdiode“ $D=1\text{N}5400$ und einen Glättungskondensator mit $C=10\text{pF}$ aufgebaut. Als Messgerät nutzten Sie ein Oszilloskop (Rigol DS1000E). Die Schaltung ist in nebenstehender Skizze gezeichnet.

Ihr Kollege hat Sie bereits darauf hingewiesen, dass bei hohen Frequenzen manche Dioden ein Problem mit dem Gleichrichten bekommen. Das haben Sie beim Durchmessen des Aufbaus und Blick auf das Oszilloskop auch gemerkt...

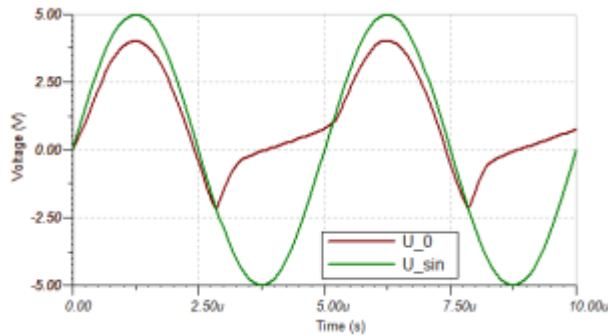
Schreiben Sie den erwarteten Signalverlauf vor der jeweiligen Simulation auf. Beachten Sie, dass Sie in der Simulation ein eingeschwungenes System betrachten müssen!

1. Suchen Sie in der [Anleitung des Oszilloskops](#) die Werte der Eingangsimpedanz, welche in der Schaltung für den Eingangswiderstand R_E und die Eingangskapazität C_E benötigt werden.

Bilden Sie die Schaltung in mit den Angaben von oben TINA TI nach (**Schaltung 1**). Dabei ist - wie in der Skizze dargestellt - die Eingangsimpedanz des Oszilloskops zu berücksichtigen.

Simulieren Sie die Schaltung 1 mit dem angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf.

5. Gehen Sie nun noch einen Schritt zurück und versuchen etwas mehr Strom über die Diode fließen zu lassen. In Schaltung 2 war der Strom durch R_E begrenzt und die Diode damit noch nicht über $U_S = 0,7V$ betrieben. Die Idee ist nun in **Schaltung 3** auch den Eingangswiderstand auf $R_E = 50 \Omega$ zu schalten (dies ist bei einigen Oszilloskopen möglich). Der Rest der Schaltung 3 gleicht Schaltung 2. Simulieren Sie die Schaltung 3 mit dem bisherig angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf.
6. Nun scheinen Sie dem Problem näher zu kommen. Sie variieren Eingangswiderstand auf $R_E = 500 \Omega$ (**Schaltung 4**). Simulieren Sie die Schaltung 4 mit dem angegebenen Signal. Beschreiben Sie kurz den erwarteten und gemessenen Signalverlauf.
7. Ihr Kollege gibt Ihnen den Tipp, dass der Verlauf (siehe Diagramm rechts) typisch sei für



1. einen zu großen Sperrverzug / eine zu große Sperrverzugszeit (reverse recovery time t_{rr}). Diese ist in Tina über die Transitzeit (Transit Time TT) nachgebildet
 2. eine zu große Sperrschichtkapazität (junction capacity C_j oder diode capacity C_D).
8. Diese Werte sind in Tina TI über folgendes Vorgehen veränderbar: Doppelklick auf die Diode » Klick auf ... bei Type » Suchen der genannten Größen.
 Sie wollen nun analysieren wie jeweils der Sperrverzug und die Sperrschichtkapazität auf den Spannungsverlauf (bei Schaltung 4) bewirkt.
 Simulieren und beschreiben Sie dafür den Spannungsverlauf wenn
1. einerseits den Sperrverzug auf $0s$ zurückgesetzt oder
 2. andererseits die Sperrschichtkapazität auf $0F$ zurückgesetzt wird.

9. Wählen Sie statt der Diode $D=1N5400$ die Diode $D=1N4148$ und simulieren Sie nochmals die Schaltung 3 und Schaltung 1.
 Wie verhält sich nun der Spannungsverlauf und warum?

From:

<https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik_mr_spo1/uebung_2.1.1

Last update: **2026/09/25 13:12**

